

ICS 77.150.70
H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1053—2015

电子薄膜用高纯钴靶材

High-purity cobalt sputtering target used in electronic film

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位:宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人:王学泽、李勇军、郑文翔、罗俊锋、袁海军、熊晓东、陈勇军、刘丹、陆彤、袁洁、张涛。

电子薄膜用高纯钴靶材

1 范围

本标准规定了电子薄膜用高纯钴靶材(以下简称高纯钴靶)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于电子薄膜制造用的各类高纯钴靶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8651 金属板材超声板波探伤方法

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 1011 高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

靶材 target

溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在阳极表面沉积。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 高纯钴靶按纯度分为4N5(99.995%)、5N(99.999%)两个级别。

4.1.2 高纯钴靶按焊接方式分为钎焊和非钎焊。

4.2 化学成分

高纯钴靶化学成分及杂质元素要求应符合表1的规定。

4.3 晶粒尺寸

高纯钴靶的晶粒尺寸应符合表2的规定。需方如有特殊要求时,由供需双方商定,并在订货单(或合同)中注明。